Oscillatore di Pierce: Progetto su AWR

Gianmarco Cerutti Ivan Matraxia Giovanni Valentini

1 Specifiche

L'oscillatore di Pierce è un oscillatore costruito con il principio della retroazione positiva, il quale prevede uno stadio amplificatore emettitore comune, retroazionato attraverso una rete di Colpitts contenente un quarzo. Elenchiamo le specifiche di progetto:

- Frequenza di oscillazione: $f_0 = 12MHz$
- Alimentazione: $V_{cc} = 12V$
- Resistenza di uscita: $R_0 = 50\Omega$
- Dinamica di uscita sul collettore: $V_{pp} = 12V$
- Transistor: BFG92A/X

2 Quarzo

Il quarzo è un componente caratterizzato da un elevato fattore di merito Q, quindi consente di ottenere oscillatori con una minore banda frazionale. Il modello del quarzo prevede una serie di componenti R_1 , L_1 , C_1 , i quali stabiliscono la risonanza serie f_s . Al modello si aggiunge una capacità parallelo C_0 , dovuta al package metallico contenente il quarzo; solitamente $C_0 >> C_1$. I valori scelti da noi sul CAD AWR, sono realistici per un quarzo, ed in particolare abbiamo scelto:

 $f_s = 12MHZ$ $R_1 = 10\Omega$ $C_1 = 0,01pF$ $C_0 = 7pF$ $L_1 = 1.759e4\mu H$

3 Amplificatore

Per la realizzazione dell'amplificatore abbiamo scelto di utilizzare il transistor BFG92A/X. Leggendo il datasheet, abbiamo scelto di fissare la corrente di lavoro sul collettore $I_Q = 3mA$. Riportiamo in figura (1) lo schema circuitale.

Per i calcoli della polarizzazione, abbiamo considerato che il β del transistor sia almeno $\beta = 100$, quindi ne segue $I_B = 30\mu A$. Affinché I_B sia trascurabile, imponiamo una corrente sulla rete di polarizzazione R_1 - R_2 , pari ad 1mA. Ne risulta:

$$R_1 + R_2 = \frac{V_{cc}}{1mA} = 12K\Omega$$

Sulla base di ciò, scegliamo arbitrariamente

$$R_1 = 9200\Omega \quad R_2 = 2800\Omega$$

Per calcolare infine la resistenza di degenerazione R_3 , calcoliamo

$$V_{R_3} = V_B - V\gamma = V_{cc} \frac{R_2}{R_1 + R_2} - V_\gamma = 2.1V$$

 $R_3 = \frac{V_{R_3}}{I_Q} = 700\Omega$

Inserendo tali valori nel CAD, abbiamo calcolato più accuratamente tale valore. Attraverso un tuning su R_3 , è risultato $R_3 = 650\Omega$. Si è aggiunta una capacità di bypass C_4 sull'emettitore (in parallelo ad R_3), la quale deve risultare un corto alla frequenza di lavoro. Imponendo che la sua impedenza ad ω_0 sia inferiore ad 1Ω , ne abbiamo calcolato il valore minimo.

$$|X_c| < 1\Omega \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{\omega_0 C} < 1\Omega$$
$$C > \frac{1}{2\pi f_0 \cdot 1\Omega} = 13262 pF$$

Scegliamo quindi il valore $C_4 = 15000 pF$. Concludiamo mettendo una induttanza L_1 sul collettore, che staticamente si comporta come un corto, per fissare il punto di lavoro. Per ottenere una dinamica di $12V_{pp}$ sul collettore, sarebbe necessaria una resistenza di carico

$$R_{in0} = \frac{V_p}{I_Q} = \frac{6V}{3mA} = 2000\Omega$$

Essendo la nostra resistenza d'uscita $R_0 = 50\Omega$, è necessario introdurre una rete di adattamento che abbia un rapporto di trasformazione

$$\frac{R_{in0}}{R_0} = 40$$

4 Rete di trasformazione e Rete di Colpitts

La rete di adattamento interposta tra collettore e R_0 , ha il duplice scopo di trasformare il carico, e di mostrare una capacità equivalente C_{eq} . Tale capacità costituirà assieme agli elementi C_1 , L_Q , la rete di Colpitts.

La rete di adattamento è una rete di trasformazione a presa centrale sul ramo capacitivo. Essa è costituita dagli elementi come in figura (2). Bisogna porre la frequenza di risonanza della rete ω'_0 minore della pulsazione di lavoro dell'oscillatore ω_0 al fine di ottenere un comportamento capacitivo ad $\omega = \omega_0$. In particolare si è scelto

$$\omega_0' = \frac{96}{100}\omega_0$$

Le trasformazioni equivalenti sono riportate in (12). Le equazioni di progetto che derivano dalla teoria sulla rete considerata sono:

$$\omega_0' = \frac{1}{\sqrt{L_1 C}} \qquad Q = \omega_0 C R_{in0} \qquad \frac{R_{in0}}{R_0} = \frac{1 + Q^2}{1 + Q_i^2}$$

Fissando un fattore Q=40ne risulta

$$Q_i = \sqrt{\frac{1+Q^2}{R_{in0}/R_0} - 1} = 6.25$$

Ricaviamo il valore del componente C_2

$$C_2 = \frac{Q_i}{\omega_0 R_0} = 1658 pF$$

Fisso $L = 1\mu H$, da cui ottengo

$$C = \frac{1}{L_1(\omega'_0)^2} = \frac{1}{L_1\left(\frac{96}{100}\omega_0\right)^2} = 191pF$$

Considerando che nelle trasformazioni serie-parallelo e parallelo-serie le capacità rimangono pressoché inalterate, possiamo approssimativamente dire

$$C = \frac{C_3 C_2}{C_3 + C_2} \quad \Rightarrow \quad C_3 = \frac{C_2 C}{C_2 - C} = 216 pF$$

Possiamo ora valutare la C_{eq} della rete ad $\omega=\omega_0$

$$Y = G_{in0} + j\omega_0 C + \frac{1}{j\omega_0 L_1} = G_{in0} + j\omega_0 C \left[1 - \frac{1}{\omega_0^2 L_1 C} \right]$$
$$Y = G_{in0} + j\omega_0 C \left[1 - \left(\frac{\omega_0'}{\omega_0}\right)^2 \right]$$
$$C_{eq} = C \left[1 - \left(\frac{\omega_0'}{\omega_0}\right)^2 \right] = 17pF$$

Utilizziamo la condizione di Barkhausen per ricavare il valore dell'ultimo componente

$$g_m R_{in0} \frac{C_{eq}}{C_1} = 1 \quad \Rightarrow \quad C_1 = g_m R_{in0} C_{eq} = \frac{I_Q}{V_T} R_{in0} C_{eq} = 3923 pF$$

Ritroviamo come imposto dalla teoria della rete di Colpitts che $C_1 >> C_{eq}$.

Il dimensionamento è avvenuto con successo ed ha portato i seguenti risultati:

- $C_1 = 3923 pF$
- $C_2 = 1658 pF$
- $C_3 = 216 pF$
- $L_1 = 1 \mu H$

5 Condizione di Barkhausen

Le condizioni di Barkhausen di un oscillatore sono, se espresse in parte reale ed immaginaria

$$\Re\{A(j\omega)f(j\omega)\} = 1 \qquad \Im\{A(j\omega)f(j\omega)\} = 0$$

Per verificarle, abbiamo considerato i sottocircuiti in figura (3) (amplificatore e rete risonante) ed abbiamo utilizzato lo strumento di misura "OSC-TEST". Esso si interpone in un punto dell'anello percorso dal segnale al fine di determinarne il guadagno. Il guadagno ad anello è rappresentato dal parametro di scattering S_{21} dell'OSCTEST. Nel grafico di Barkhausen (4) abbiamo quindi riportato $\Re\{S_{21}\}, \Im\{S_{21}\}$.

Attraverso un marker, individuiamo l'annullamento della parte immaginaria alla frequenza di 12.00261*MHz*, ed a tale frequenza una parte reale di circa 1,5. Ricordiamo che per l'innesco delle oscillazioni è necessario che $\Re\{S_{21}\} > 1$. Saranno poi le non linearità del dispositivo a portare l'inviluppo delle oscillazioni ad essere costante, al prezzo di una distorsione sul segnale in uscita.

6 Oscillatore

Per poter studiare il nostro oscillatore, abbiamo utilizzato lo strumento di misura "OSCAPROBE", collegato sulla base del transistor, come in figura (5). L'OSCAPROBE, inietta un segnale sinusoidale di test all'oscillatore, in un range di frequenze da noi specificato; la ricerca del punto di lavoro, avviene con step di frequenza F_{step} , ciascuna a sua volta analizzata con step di tensione V_{step} . Abbiamo scelto

$$F_{step} = 1000$$
 $V_{step} = 1000$

Nel grafico (6) abbiamo inserito la misura non lineare in tensione "VHARM". La simulazione converge con successo alla frequenza 12,0026*MHz*. La sinusoide in uscita ha $V_p = 1,14V$. Con dei marker abbiamo visualizzato i valori in *dB* delle armoniche:

- $V_{1,Harm} = +1,136dB$
- $V_{2,Harm} = -50,74dB$
- $V_{3,Harm} = -73,09dB$

Concludiamo che la distorsione di seconda armonica è di circa -50dB, mentre quella di terza armonica è di circa -70dB.

7 Rumore

Come ultimo passo abbiamo analizzato il nostro oscillatore dal punto di vista del rumore. Attraverso il grafico (7) si è riportato il Single Side band to Carrier Ratio (SSCR). Come si evince dai marker riportati, la pendenza risulta essere circa -20dB/dec, proprio come ci si aspetta dal rumore di tipo termico.

8 Realizzazione Oscillatore

Per la realizzazione del circuito è stato creata la netlist attraverso il software Spice, inserendo dei pin per l'alimentazione, per la massa e per l'uscita all'interno dello schematico. La netlist viene quindi usata come input dal programma FreePCB, con il quale è stato eseguito il routing delle piste, senza particolari cure per le dimensioni poiché le correnti in gioco sono molto piccole e quindi non è stato necessario tracciare connessioni larghe. Le piazzole invece sono state fatte il più grande possibile al fine di rendere facile la loro foratura. Il risultato è in figura (1).

Attraverso il trasferimento di toner ed attacco chimico attraverso il cloruro ferrico è stato fatto l'etching sulla vetronite ramata, dopodiché sono state forate le piazzole e saldati i componenti.

9 Misure

Le misure non hanno dato i risultati previsti, perché i valori di capacità, resistenza e induttanza trovati attraverso il progetto dell'oscillatore non erano tra quelli commerciali o non erano disponibili. Inoltre non è stato trovato neanche il transistor utilizzato su MWO, quindi è stato sostituito con un BC547C, un NPN con frequenza di transizione di 100MHZ, purtoppo non molto lontana dalla frequenza di oscillazione del circuito.

Fatte queste premesse si giustifica l'ampiezza della sinusoide minore (620mV circa) rispetto a quella ottenuta attraverso le simulazioni.

La frequenza di oscillazione invece è uguale a quella trovata attraverso le simulazioni, ovvero 12MHz.

Infine l'analizzatore di spettro mostra la presenza di una distorsione di seconda armonica ben peggiore rispetto a quella ottenuta con il CAD: si è infatti misurata un valore di -30dB contro i -50dB di MWO.



Figura 1: Amplificatore



Figura 2: Rete risonante



Figura 3: Misura con OSCTEST



Figura 4: Plot di Barkhausen



Figura 5: Misura con OSCAPROBE



Figura 6: Analisi spettrale dell'oscillatore



Figura 7: Single Side band to Carrier Ratio



Figura 8: Trasformazioni circuitali equivalenti



Figura 9: File Gerber



Figura 10: Circuito Ottenuto



Figura 11: Oscilloscopio



Figura 12: Analizzatore Di Spettro